1. ラマン散乱

物質に入射、吸収された光は、物質と相互作用を起 こしたのち、その一部は再び散乱光として物質から放出される. この入射光と散乱光のエネルギーが等しい場合(弾性散乱), レイリー散乱と呼ばれる.一方,入射光が物質における様々な エネルギー準位(格子振動,分子の回転,電子準位など)に由 来してエネルギーを変化させた場合(非弾性散乱),これをラ マン散乱と呼ぶ¹⁾.入射光とラマン散乱光のエネルギー差(ラ マンシフト. 単位 cm⁻¹)において,入射光より散乱光の方のエ ネルギーが小さく(または大きく)なった場合、ストークス・ ラマン散乱(またはアンチストークス・ラマン散乱)と呼ばれ る. ラマンシフトは入射光の波長には依らず、物質のエネルギ ー準位に依存することを用いて、 ラマン散乱スペクトルから物 質の同定・分析などが可能である.入射光(エネルギーE_i),散 乱光(エネルギーE_s)およびラマンシフト(周波数 v_R)はエネ ルギー保存則 $E_i = E_s \pm h v_R$ を満たし、+ (-) がストークス (アン チストークス) ラマン散乱に対応する. ここで, h はプランク 定数である. ラマン散乱光はレイリー散乱光に比べ非常にその 強度は非常に弱く,更にレイリー散乱光との波長差は大きくな いため、ラマン散乱スペクトル計測にはレイリー散乱光を効率 よく除去することが重要となる. レイリー散乱光の除去には, フィルター (ノッチフィルター,エッヂフィルターなど)やト リプルモノクロメーターが、また入射光としては一般に単色の レーザー光が用いられる.

2. 単層カーボンナノチューブのラマン散乱スペクトル

ラマン散乱分光法は、単層カーボンナノチューブ (single-walled carbon nanotube, SWNT)の発見当初から広く用 いられている光学分析手法の1つである²⁾. SWNTのラマン散 乱スペクトルにはその格子振動(フォノン)に由来する特徴的 なピークが現れ,それぞれ G-band(1590 cm⁻¹付近), D-band(1300 cm⁻¹付近), RBM (radial breathing mode) ピーク (100 から 350 cm⁻¹) および 2D (もしくは G') -band (2700 cm⁻¹付近) と呼ば れる. 図1に SWNT (アルコール触媒 CVD 法³⁾を用いて合成) の典型的なラマン散乱スペクトルを示す.励起光の波長はアル ゴンイオンレーザー (波長 488.0 nm, エネルギー2.54 eV)を用 いた.

一般に G, D および 2D-band は炭素原子からなる物 質から計測される. G-band はグラファイトにおける炭素原子の 6 員環構造の面内伸縮振動に, D-band はその欠陥構造に由来す ることから, G-band と D-band の強度比 (G/D 比) は, SWNT や多層カーボンナノチューブ (multi-walled carbon nanotube, MWNT), グラファイト, グラフェンにおける結晶性の高さを 示す指標として広く用いられている. ダイアモンドやグラファ イトおよびグラフェンの G-band は単一のピークとして計測さ れるが, SWNT の G-band はその円筒構造に由来して 6 つの異 なる対称性を有するピークから構成されることが知られてい る. このうち特に強いピークは、 G^+ ピークおよび G^- ピークと 呼ばれている. G^+ ピーク(ラマンシフト ω_{G^+})と G^- ピーク(ω_{G^-})のラマンシフトの差は SWNT の直径に依存し($\omega_{G^+}-\omega_{G^-}$ = C/d_t^2)、半導体 SWNT で $C = 47.7 \text{ cm}^{-1} \text{ nm}^2$ 、金属 SWNT で $C = 79.5 \text{ cm}^{-1} \text{ nm}^2$ と現される⁴). ただし、 d_t を SWNT の直径(nm) とする. 直径の異なる多数の SWNT から計測された G-band から明確に SWNT 直径を算出することは難しいが、このように SWNT の直径分布を見積もることは可能である.

半導体 SWNT の場合, $G^+ \ell' - \rho が 6 員環構造の面内$ $伸縮振動における LO(縦波) フォノン, <math>G^- \ell' - \rho ň$ TO(横 波) フォノンに対応するのに対する. これは SWNT の曲率効果 によって TO フォノンの振動数が低下した結果と理解できる. 一方, 金属 SWNT の場合は $G^+ \ell' - \rho ň$ TO フォノン, $G^- \ell' - \rho ň$ LO フォノンに対応する. 金属 SWNT の LO フォノンの振 動数がコーン異常効果 ⁵⁾によって大きくダウンシフトしたこと に起因するとされる. 金属 SWNT の $G^- \ell' - \rho t$ BWF (Breit Wigner Fano) $\ell' - \rho b$ も呼ばれ⁶, 幅が広く非対称なピークと して現れる.

D-band は欠陥構造による非弾性散乱を伴う二重共鳴 効果 ⁷⁾によってラマンスペクトルに現れるピークである. 一般 にラマンシフトは励起光のエネルギーに依存しないが,二重共 鳴効果により D-band のラマンシフト ($\omega_{\rm D}$) は励起光エネルギ ー (E) 依存性を持つ ($\partial \omega_{\rm D} / \partial E$ =53 cm⁻¹ eV⁻¹) ⁸⁾.

一方、低周波数領域の RBM ピークは SWNT 固有の ピークである. RBM は、SWNT の直径が等方的に変化する振 動(全対称振動)に対応し、その振動数は直径に反比例するこ とが理論から示されている⁹⁾. 実際、実験測定から、RBM ピー クのラマンシフト (ω_{RBM} cm⁻¹) と SWNT の直径との関係は一般 に $\omega_{RBM}=A/d_t+B$ と表現される. ここで A、B は定数であり、



図 1 SWNT からのラマン散乱スペクトル.励起光 波長は 488.0 nm.

A=248, B=0¹⁰やA=217.8, B=15.7¹¹など様々な定数が提案され ている.A およびBの値は,液体中への孤立分散した SWNT や, バンドル構造¹²をとっているもの,また基板と接触しているか など,様々な条件によって変化する.

2D-band のラマンシフト (ω_{2D}) は, D-band と同様に 励起光エネルギーに依存して変化する⁷⁾ ($\partial \omega_{2D}$ / ∂E =106 cm⁻¹ eV⁻¹). さらに 2D-band はグラフェンシート層間における相互作 用の影響を受ける. その為, SWNT やグラフェンでは単一のピ ークであるが, 複数の面からなるグラフェンシートやグラファ イト, MWNT では複数のピークから構成される. これを利用し, 2D-band の形状から SWNT と二層カーボンナノチューブ (double-walled carbon nanotube, DWNT) の判別¹³, さらにグ ラフェンやグラファイトにおける層数の計測が可能である¹⁴).

3. 共鳴ラマン散乱効果と片浦プロット

ラマン散乱分光法を用いることで多くの情報を得る ことができるが、SWNTのラマン散乱スペクトルの分析・解釈 の際には共鳴ラマン散乱効果¹²⁾が非常に重要である.一般に、 入射光または散乱光が物質の光学遷移エネルギーと一致した 場合,非常に強いラマン散乱光が生じる共鳴ラマン散乱現象が 起きる.この時、入射光(または散乱光)による共鳴を入射光 共鳴(または散乱光共鳴)と言う.

SWNT の電子構造にはその擬1次元構造に由来し, バンホーブ (van Hove) 特異点が現れる. SWNT における光学 遷移は直接バンド間遷移であるため、この特異点間に対応する エネルギーが SWNT の光学遷移エネルギー (E_{ii}) となり, カイ ラリティ(n,m)によって一意的に決まる.ただし、エキシトン効 果が強く現れるため、SWNTの光学遷移エネルギー(Ei)と電 子構造のバンド間エネルギーとは完全には一致しない. バンホ ーブ特異性に由来する鋭い電子構造により, SWNT は光学遷移 エネルギーと等しい光を非常に強く吸収・放出する為,SWNT から測定されるラマン散乱スペクトルは強い共鳴ラマン散乱 効果が現れる.励起光のエネルギーとその励起光に共鳴して現 れる RBM ピークのラマンシフトの関係をプロットしたものを 片浦プロットと呼ぶ¹⁵⁾. 図2に片浦プロットを示す. 白抜き丸 印(o)が半導体 SWNT, 丸印(●)が金属 SWNT に対応し, それぞれのカイラリティ(n,m)を示した.図2に示したデータは, 実験による測定値から求められたもの ¹¹⁾で、ラマンシフト (ω_{RBM}) と直径との関係は、 ω_{RBM} (cm⁻¹)=217.8/d_t (nm)+15.7 を 用いている.図2において半導体 (S) SWNT の E_{11}^{S} , E_{22}^{S} およ び E_{33} ^Sと金属(M) SWNTの E_{11} ^Mの光学遷移エネルギーに対応 して、プロットがグラフの左下から右上へ帯状に並んでいる. これは、光学遷移エネルギーとラマンシフトの双方がおおよそ SWNT の直径に反比例することに由来する. さらに帯状の中に 直線でつないだファミリーパターン¹⁶⁾と呼ばれるパターンを 見て取ることができる.ファミリーパターンとはカイラリティ (n, m)において, 等しい 2n+m の値を持つ直径が近い SWNT の 集合であり,ファミリーパターンの形状は,光学遷移エネルギ ーのカイラル角依存性に由来している.また,RBM ピークの 発光強度はカイラル角に依存することが知られている¹⁷⁾.カイ ラル角が大きくなるほど RBM ピーク強度が強くなることから, 例えばアームチェアー型((*n*,*n*)) SWNT の RBM ピークは非常 に弱く,逆にジグザグ型((*n*,0)) SWNT からは強い RBM ピー クを測定することができる.

励起光のエネルギーに対して, 共鳴幅 Г (バンドル構 造をした SWNT の場合は, F=120 meV, 孤立した SWNT では F=60 meV¹²⁾)に含まれる光学遷移エネルギーを有する SWNT か ら, 共鳴ラマン散乱効果により強いラマン散乱光が計測される. 図 2 の片浦プロット上に, 典型的に用いられるレーザー光のエ ネルギーを示した.1 つの励起光を用いた測定では, 非常に限 られたカイラリティしか計測しできないことがわかり,図 2 の 片浦プロットに従うと図 1 に示したラマン散乱スペクトルの RBM ピークにおいて, 100 から 230 cm⁻¹の範囲が半導体 SWNT に, 240 から 290 cm⁻¹が金属 SWNT の RBM ピークであること が分かる.より高分解能の測定系を用いることで各カイラリテ ィに対応した RBM ピークを分解して測定することも可能であ る.

SWNT のカイラリティを同時に多く計測する手法と して近赤外蛍光 (photoluminescence, PL) 分光法 ¹⁸⁾があるが, PL 分光法は半導体 SWNT のみからしかスペクトルを計測でき



図2 片浦プロット.

ないという欠点がある.一方, ラマン散乱分光法では,半導体 と金属 SWNT の両方から計測できるが,この強い共鳴ラマン散 乱効果により非常に限られたカイラリティしか測定できない. 従って,多くの異なる波長の励起レーザーによる測定が必要に なる.また,RBM ピークを用いた直径分布の比較や,金属・ 半導体 SWNT の割合に対する分析においても,単一の励起光に よる測定では,結果の解釈を間違えてしまう可能性がある.そ の為,これらの分析には,ラマン散乱のような強い共鳴効果が ない光吸収分光法と合わせて行う必要がある.更に,G-band も 共鳴ラマン散乱効果によってその強度が増強されている.その 為,共鳴条件が変化することで同じ SWNT サンプルでも G-band のピーク形状は大きく変化する.

また, SWNT の光吸収には偏光依存性がある. これ までの議論はすべて SWNT の軸方向に平行な偏光方向を持つ 光について行ってきたが, 垂直の偏光方向の光に対しては光学 遷移エネルギーが異なる. この垂直な偏光方向の光の吸収は非 常に弱いが¹⁹, 垂直方向での励起でのラマン散乱スペクトルも 測定されている²⁰⁾.

4. ラマンスペクトルの環境依存性

一般にラマン散乱スペクトルには温度依存性がある. 物質の温度が上昇するとピークが低波数側へシフトし,ピーク 幅は増加,強度は減少をする.これらは格子振動における非調 和振動成分に由来する.また,ストークス散乱光とアンチスト ークス散乱光の強度(*I_s*および*I_{As}*)の強度比は,物質が熱平衡 にあるとき*I_{As}/I_s*=exp(-*h* v_k/*k*T)の関係がある.ここで,kはボ ルツマン定数,T は物質の温度である.この関係を用いてラマ ン散乱スペクトルから物質の温度を算出することができるが, SWNTにおいては,強い共鳴ラマン散乱効果のため,*I_{As}*/*I_s*を 単純な温度の関数で表すことができない.また,熱伝導率の低 い基板上や,架橋構造をしたSWNT,真空中でのラマン散乱ス ペクトル測定では,励起光照射によりSWNTの温度が容易に上 がってしまう.SWNTのラマンスペクトルは強い温度依存性が あるため²¹⁾,正確な測定のためには励起光のパワー密度を抑え ることが重要である.

また,SWNT のラマン散乱スペクトルは応力依存性 も有する.その為,SWNT と強く相互作用する水晶基板などの 上や,基板や周辺物質などが変形することによって,そのラマ ン散乱スペクトルが変化することも報告されている²²⁾.さらに、 SWNT が界面活性剤などによって囲まれている場合には,*E_{ii}* の値が 100 meV 程度シフトするので,片浦プロットの補正が必 要になる²³⁾.

<参考文献>

1) 濱口 宏夫, 平川 暁子編, ラマン分光法, 学会出版セン

ター, (1988).

2) A. M. Rao, et al : Diameter-selective Raman scattering from vibrational modes in carbon nanotubes, Science, **275** 187 (1997).

3) S. Maruyama, et al : Low-temperature synthesis of high-purity single-walled carbon nanotubes from alcohol, Chemical Physics Letters, **360**, 229 (2002).

4) A. Jorio, et al : G-band resonant Raman study of 62 isolated single-wall carbon nanotubes, Physical Review B, **65**, 155412 (2002).

5) H. Farhat, et al : Phonon Softening in Individual Metallic Carbon Nanotubes due to the Kohn Anomaly, Physical Review Letters, **99**, 145506 (2007).

6) S. D. M. Brown, et al : Origin of the Breit-Wigner-Fano lineshape of the tangential G-band feature of metallic carbon nanotubes, Physical Review B, **63**, 155414 (2001).

 L. G. Cancado, et al : Stokes and anti-Stokes double resonance Raman scattering in two-dimensional graphite, Physical Review B, 66, 035415 (2002).

8) R. Saito, et al : Probing phonon dispersion relations of graphite by double resonance Raman scattering, Physical Review Letters, **88**, 027401 (2002).

9) R. Saito, et al : Raman intensity of single-wall carbon nanotubes, Physical Review B, **57**, 4145 (1998).

10) A. Jorio, et al : Structural (n, m) determination of isolated single-wall carbon nanotubes by resonant Raman scattering, Physical Review Letters, **86**, 1118 (2001).

11) P. T. Araujo, et al : Third and fourth optical transitions in semiconducting carbon nanotubes, Physical Review Letters, **98**, 067401 (2007).

12) C. Fantini, et al : Optical transition energies for carbon nanotubes from resonant Raman spectroscopy: Environment and temperature effects, Physical Review Letters, **93**, 147406 (2004).

13) R. Pfeiffer R, et al : Resonance Raman scattering from phonon overtones in double-wall carbon nanotubes, Physical Review B, **71**, 155409 (2005).

14) A. C. Ferrari, et al : Raman spectrum of graphene and graphene layers, Physical Review Letters, **97**, 187401 (2006).

15) H. Kataura, et al : Optical properties of single-wall carbon nanotubes, Synthetic Metals, **103**, 2555 (1999).

16) G. G. Samsonidze, et al : Family behavior of the optical transition energies in single-wall carbon nanotubes of smaller diameters, Applied Physics Letters, **85**, 5703 (2004).

17) K. Sato, et al : Excitonic effects on radial breathing mode intensity of single wall carbon nanotubes, Chemical Physics Letters, 497, 94 (2010).

18) S. M. Bachilo, et al : Structure-assigned optical spectra of single-walled carbon nanotubes, Science, **298**, 2361 (2002).

19) H. Ajiki, T. Ando : Aharonov-Bohm effect in carbon nanotubes, Physica B, **201**, 349 (1994).

20) A. Jorio, et al : Resonance Raman spectra of carbon nanotubes by cross-polarized light, Physical Review Letters, **90**, 107403 (2003).

21) N. R. Raravikar et al : Temperature dependence of radial breathing mode Raman frequency of single-walled carbon nanotubes, Physical Review B, **66**, 235424 (2002).

22) S. B. Cronin, et al : Resonant Raman spectroscopy of individual metallic and semiconducting single-wall carbon nanotubes under uniaxial strain, Physical Review B, **72**, 035425 (2005).

23) A. R. T. Nugraha, et al., : Dielectric constant model for environmental effects on the exciton energies of single wall carbon nanotubes ,Applied Physics Letters **97**, 091905 (2010).